En la tabla \ref{tab:1} es notable que los puntos de operación estáticos experimentales de los circuitos \ref{fig:7} y \ref{fig:8} son iguales a los ya calculados teóricamente en \ref{tab:Qt}. En particular, cabe señalar que esto es debido a la ausencia de polarización en la unión base-emisor del transistor. No obstante, el punto estático de operación de la tabla \ref{tab:1} para el circuito de la figura \ref{fig:9} no coincide con los valores teóricos de la otra tabla mencionada, sin embargo, al recordar que, teóricamente, se obtuvo una tensión colector emisor alta en módulo y negativa; y observando la gráfica \ref{fig:1cir3} donde la tensión alcanza un valor sumante bajo, se puede decir que el transistor se encuentra saturado. Esto último debido a que, a diferencia de los circuitos anteriores existe una polarización directa en la unión base emisor.

Para el circuito de la figura \ref{fig:10} el punto de operación estático tiene un comportamiento similar que el del circuito de la figura \ref{9}, ya explicado en el párrafo anterior. Por añadidura de RE y observando la gráfica \ref{fig:2a} el transistor se encuentra saturado, aunque es notable que la $V\_{CE}$ incrementó 10mV.

Al analizar la figura \ref{fig:11} y comparando el primer valor de la tabla \ref{tab:3} y el $Q\_5$ de la tabla \ref{tab:Qt} es notable que se realizó una buena aproximación del punto estático de operación, vinculado a la zona activa del transistor, con un error que puede estar relacionado a la toma del valor $h\_{FE}$ por debajo de lo establecido por la condiciones del circuito planteado, esto se deduce debido a que la gráfica \ref{fig:3a} posee un Q con una intensidad de colector de poco más de 5mA, mayor que la calculada teóricamente.